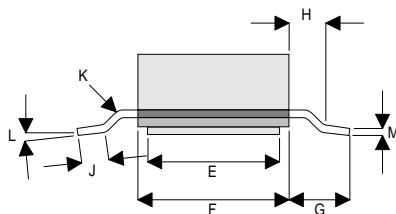
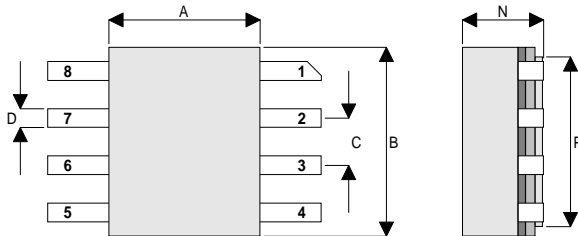


MECHANICAL DATA



SO8 PACKAGE

- PIN 1 – SOURCE
- PIN 2 – DRAIN
- PIN 3 – DRAIN
- PIN 4 – SOURCE
- PIN 5 – SOURCE
- PIN 6 – GATE
- PIN 7 – GATE
- PIN 8 – SOURCE

Dim.	mm	Tol.	Inches	Tol.
A	4.06	±0.08	0.160	±0.003
B	5.08	±0.08	0.200	±0.003
C	1.27	±0.08	0.050	±0.003
D	0.51	±0.08	0.020	±0.003
E	3.56	±0.08	0.140	±0.003
F	4.06	±0.08	0.160	±0.003
G	1.65	±0.08	0.065	±0.003
H	0.76	+0.25 -0.00	0.030	+0.010 -0.000
J	0.51	Min.	0.020	Min.
	1.02	Max.	0.040	Max.
K	45°	Max.	45°	Max.
L	0°	Min.	0°	Min.
	7°	Max.	7°	Max.
M	0.20	±0.08	0.008	±0.003
N	2.18	Max.	0.086	Max.
P	4.57	±0.08	0.180	±0.003

**GOLD METALLISED
MULTI-PURPOSE SILICON
DMOS RF FET
2.5W – 28V – 1GHz
SINGLE ENDED**

FEATURES

- SIMPLIFIED AMPLIFIER DESIGN
- SUITABLE FOR BROAD BAND APPLICATIONS
- VERY LOW C_{rss}
- SIMPLE BIAS CIRCUITS
- LOW NOISE
- HIGH GAIN – 13 dB MINIMUM

APPLICATIONS

- HF/VHF/UHF COMMUNICATIONS
from 1 MHz to 2 GHz

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_{case} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated)

P_D	Power Dissipation	17.5W
BV_{DSS}	Drain – Source Breakdown Voltage	65V
BV_{GSS}	Gate – Source Breakdown Voltage	±20V
$I_{D(sat)}$	Drain Current	1A
T_{stg}	Storage Temperature	–65 to 150°C
T_j	Maximum Operating Junction Temperature	200°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_{case} = 25°C unless otherwise stated)

Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
BV _{DSS} Drain–Source Breakdown Voltage	V _{GS} = 0 I _D = 10mA	65			V
I _{DSS} Zero Gate Voltage Drain Current	V _{DS} = 28V V _{GS} = 0			1	mA
I _{GSS} Gate Leakage Current	V _{GS} = 20V V _{DS} = 0			1	μA
V _{GS(th)} Gate Threshold Voltage*	I _D = 10mA V _{DS} = V _{GS}	1		5	V
g _{fs} Forward Transconductance*	V _{DS} = 10V I _D = 0.2A	0.18			S
G _{PS} Common Source Power Gain	P _O = 2.5W	13			dB
η Drain Efficiency	V _{DS} = 28V I _{DQ} = 0.1A	40			%
VSWR Load Mismatch Tolerance	f = 1GHz	20:1			—
C _{iss} Input Capacitance	V _{DS} = 0V V _{GS} = -5V f = 1MHz			12	pF
C _{oss} Output Capacitance	V _{DS} = 28V V _{GS} = 0 f = 1MHz			6	pF
C _{rss} Reverse Transfer Capacitance	V _{DS} = 28V V _{GS} = 0 f = 1MHz			0.5	pF

* Pulse Test: Pulse Duration = 300 μs , Duty Cycle ≤ 2%

THERMAL DATA

R _{THj-case}	Thermal Resistance Junction – Case	Max. 10°C / W
-----------------------	------------------------------------	---------------

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TT Electronics:](#)

[D2019UK](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru